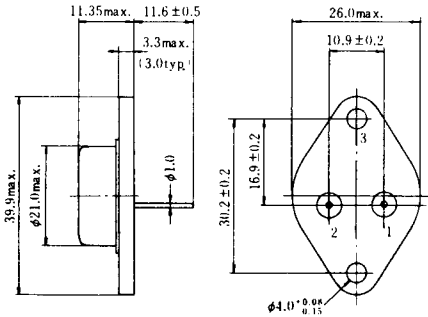


# 2SD897A

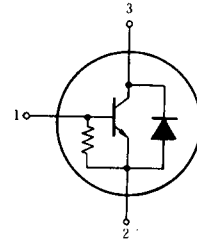
シリコン NPN 三重拡散形  
TV 水平偏向出力用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED  
TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT



(JEDEC TO-3)

1. ベース: Base
2. エミッタ: Emitter
3. コレクタ: Collector  
(ケース) (Case)  
(Dimensions in mm)



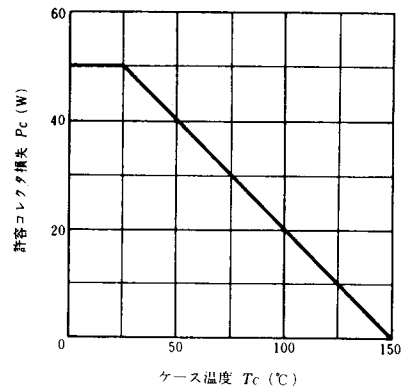
## 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	2SD897A	Unit
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CES}$	1500	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	6	V
コレクタ電流	$I_C$	1.5	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$	2	A
サージコレクタ電流	$I_{C(\text{surge})}$	5	A
ダイオード順方向電流	$I_d$	2	A
許容コレクタ損失	$P_C^*$	50	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-45 ~ +150	$^\circ\text{C}$

\*  $T_c=25^\circ\text{C}$  における許容値

\* Value at  $T_c=25^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=200\text{mA}, I_C=0$	6	—	—	V
コレクタ遮断電流	$I_{CES}$	$V_{CE}=1500\text{V}, R_{BE}=0$	—	—	0.5	mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=1\text{A}, I_B=0.2\text{A}^*$	—	—	5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(\text{sat})}$	$I_C=1\text{A}, I_B=0.2\text{A}^*$	—	—	1.5	V
エミッタ・コレクタダイオード電圧	$V_{ECF}$	$I_D=2\text{A}^*$	—	—	2.5	V
下降時間	$t_f$	$I_C=0.8\text{A}, I_{B1}=0.16\text{A}$ $I_{B2} \cong -0.2\text{A}, L_B=0$	—	—	1.0	$\mu\text{s}$

パルス測定

\* Pulse Test

各特性曲線は2SD1451参照。

See characteristic curves of 2SD1451.